13.1

# Влияние адсорбции атомов натрия на электронную структуру золотой пленки

© П.А. Дементьев<sup>1</sup>, Е.В. Дементьева<sup>1</sup>, М.Н. Лапушкин<sup>1</sup>, Д.А. Смирнов<sup>2</sup>, С.Н. Тимошнев<sup>3</sup>

E-mail: Lapushkin@ms.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 31 марта 2022 г. В окончательной редакции 8 мая 2022 г. Принято к публикации 5 июля 2022 г.

Проведены исследования электронной структуры золотой пленки, напыленной на W, при адсорбции атомов натрия. Анализ спектров фотоэмиссии из валентной зоны и остовных уровней Au 4f и Na 2p при синхротронном возбуждении в диапазоне энергий фотонов  $80-600\,\mathrm{eV}$  показал, что адсорбция Na приводит к формированию под монослоем Na интерметаллидов  $\mathrm{Na_xAu_v}$  различной стехиометрии.

Ключевые слова: адсорбция, натрий, золото, интерметаллид.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.16.53207.19207

Соединения двух металлов образуют интерметаллические соединения, свойства которых могут отличаться от свойств исходных металлов. Например, соединение CsAu является широкозонным полупроводником [1]. Кроме того, было показано, что 2D-слои интерметаллидов щелочных металлов (ЩМ) с Аи также могут образовывать ионные полупроводниковые соединения, в частности Na<sub>r</sub> Au<sub>v</sub>, которым в настоящее время уделяется больше внимания, чем остальным интерметаллидам ЩМ-Аи (см., например, [2–5]). В интерметаллических соединениях ЩМ-Аи золото выступает в необычной роли аниона, а не катиона, как в большинстве соединений [6]. Формирование интерметаллидов ЩМ-Аи при напылении атомов ЩМ на поверхность Аи происходит в два этапа. На первом этапе при напылении домонослойных покрытий ЩМ не происходит диффузии атомов ЩМ в Аи и, следовательно, не формируется интерметаллид. На втором этапе при напылении дозы атомов ЩМ более одного монослоя происходит диффузия атомов ЩМ в Au с формированием интерметаллида ЩМ-Au с сохранением на поверхности монослоя атомов ЩМ.

Целью настоящей работы является определение возможности формирования интерметаллида  $Na_xAu_y$  в процессе напыления атомов натрия на поверхность золота и выявление сопутствующих изменений электронной структуры.

Фотоэмиссионные исследования были выполнены в Российско-Германской лаборатории на синхротроне HZB BESSY II (Берлин, Германия) с использованием метода фотоэлектронной спектроскопии при возбуждении в диапазоне энергий фотонов 80—600 eV. Регистрировались фотоэлектроны по нормали к поверхности, возбуждающий пучок падал на поверхность образца под углом 45°. Исследования напыленной на вольфрам золо-

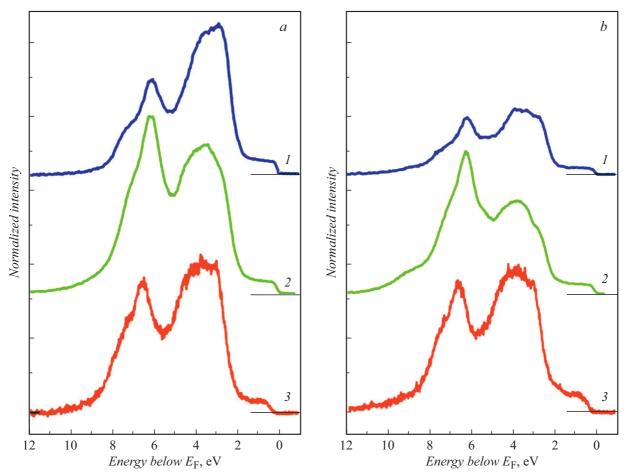
той пленки до и после напыления натрия проводились *in situ* в вакууме  $(P < 5 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{Tor})$  при комнатной температуре. Регистрировались спектры фотоэмиссии в области валентной зоны, а также спектры остовных уровней Au 4f, W 4f и Na 2p. Полное энергетическое разрешение было  $50\,\mathrm{meV}$ . Для всех приведенных далее спектров фон был вычтен по методу Ширли.

На поверхность поликристаллического W была напылена пленка Au толщиной 2.7 nm, толщина пленки была определена по подавлению пика W 4f пленкой Au c учетом известного значения глубины выхода фотоэлектронов 1.9 nm с кинетической энергией 580 eV [7,8]. Фотоэлектронные спектры валентной зоны золотой пленки при энергиях возбуждения  $h\nu = 80$ , 120 и 600 eV (рис. 1) совпадают с хорошо известными спектрами валентной зоны (см., например, [9]). В спектре валентной зоны имеются два характерных пика с энергией связи 3.3 и 6.6 eV ниже уровня Ферми  $(E_{\rm F})$ . На поверхности W присутствует незначительное количество естественного окисла, что хорошо видно из спектра остовного уровня дублета W 4f для энергии возбуждения  $h\nu = 120\,\mathrm{eV}$ (рис. 2, a). На том же рисунке приведено разложение экспериментального спектра парами функций Гаусса со спектральным расщеплением, равным 2.2 eV, и соотношением интенсивностей 4:3. Четко виден пик  $W^0$  при энергии связи  $E_b = 31.5 \,\mathrm{eV}$  относительно уровня Ферми  $(E_{\rm F})$ . Пики при  $E_b=32.27$  и 35.67 eV можно приписать состояниям  $W^{4+}$  и  $W^{6+}$  соответственно, что совпадает с результатами работ [10,11]. При  $h\nu = 600\,\mathrm{eV}$  в спектре остовного уровня дублета W 4f наблюдаются только состояния  $W^0$ . Это связано с тем, что чем больше кинетическая энергия  $(E_{kin})$  вылетающих электронов, тем с большей глубины они вылетают и тем меньше вклад поверхности в фотоэмиссионный сигнал.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Technische Universität Dresden, Dresden, Germany

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург, Россия

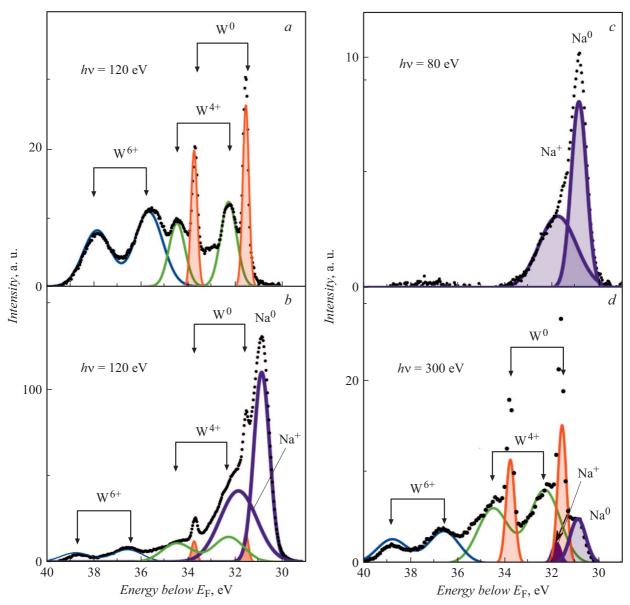


**Рис. 1.** Спектры фотоэмиссии в области валентной зоны для поверхности золота, напыленного на W, до (a) и после (b) напыления натрия при энергиях возбуждения  $h\nu=80\ (I),\ 120\ (2)$  и  $600\,\mathrm{eV}\ (3)$ . Спектры нормированы на интенсивность пика с  $E_b=3.8\,\mathrm{eV}$  до напыления Na.

Нанесение покрытия натрия приводит к изменению как спектра валентной зоны, так и спектра остовных состояний подложки. На рис. 2 приведен спектр остовных состояний дублета W 4f и Na 2p. Пик Na 2pв отличие от симметричных пиков дублета W  $4f_{5/2}$ и  $4f_{7/2}$  имеет несимметричную форму с хвостом в сторону больших энергий связи. Пик Na 2p можно разложить на два: узкий с  $E_b = 30.9\,\mathrm{eV}$  и широкий с  $E_b = 31.8\,\mathrm{eV}$  относительно  $E_\mathrm{F}$ . Первый пик связывается с состояниями Na<sup>0</sup>, а второй — с состояниями Na<sup>+</sup>, что совпадает с ранее опубликованными результатами (см., например, [12,13]). Отметим, что для  $hv = 80 \,\mathrm{eV}$ в спектре не видны пики W 4f, что отражает выход фотоэлектронов из поверхности и приповерхностной области. Увеличение энергии возбуждения до  $hv = 300 \,\mathrm{eV}$ приводит к уменьшению вклада Na 2p и увеличению вклада W 4f в фотоэмиссионный сигнал. Отношение площадей пиков  $Na^0$  к  $Na^+$  равно 1.0 для  $hv = 80 \, \text{eV}$ , 1.1 для  $h\nu = 120\,\mathrm{eV}$  и 4.4 для  $h\nu = 300\,\mathrm{eV}$ . Такое поведение свидетельствует об уменьшении доли Na<sup>+</sup> при удалении от поверхности и соответственно о формировании интерметаллида в интерфейсе Na-Au. Из

полученных результатов следует, что на поверхности золота присутствует адсорбированный монослой нейтральных атомов Na и продиффундировавших в золотую пленку атомов Na, которые после реакции с атомами золота образуют интерметаллид Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> (как это было получено ранее [3]), в котором атомы Na находятся в ионном состоянии. Этот интерметаллид в основном локализован под монослоем атомов Na. Увеличение доли Na<sup>0</sup> по сравнению с Na<sup>+</sup> вдали от поверхности может указывать на формирование металлических интерметаллидов Na<sub>r</sub>Au<sub>v</sub> с большим содержанием атомов Na по сравнению с содержанием Au, т.е. с  $x \gg y$ . На тот факт, что процесс взаимодействия атомов Na с Аи происходит в приповерхностной области, также указывает неизменность пиков Au  $4f_{5/2}$  и  $4f_{7/2}$  при энергии возбуждения  $hv = 600 \, \text{eV}$ .

Спектры валентной зоны при энергии возбуждения  $hv=80,\ 120$  и  $600\,\mathrm{eV}$  после напыления атомов Na приведены на рис. 1,b и подтверждают сделанные выше выводы. Спектр валентной зоны при энергии возбуждения  $hv=600\,\mathrm{eV}$  остается неизменным, что указывает на отсутствие изменения валентной зоны в глубине образ-



**Рис. 2.** Анализ спектров фотоэмиссии остовных уровней W 4f и Na 2p для поверхности золота, напыленного на вольфрам, до (a) и после (b-d) напыления натрия при энергиях возбуждения hv=120 (a,b), 80 (c) и  $300\,\mathrm{eV}$  (d). Точками показаны экспериментальные спектры, вклады состояний  $W^{6+}$  и  $W^{4+}$  представлены синими и зелеными линиями соответственно, вклад состояния  $W^0$ — красными линиями и областями (a,b,d), состояния Na 2p показаны фиолетовыми линиями (b-d) и областями (c,d). Цветной вариант рисунка представлен в электронной версии статьи.

ца. Так, при  $E_{kin}\sim 590-600\,\mathrm{eV}$  вклад фотоэлектронов от поверхности незначителен. Наиболее значительные изменения валентной зоны происходят при энергии возбуждения  $hv=80\,\mathrm{eV}$ : пик с  $E_b=6.1\,\mathrm{eV}$  уменьшается 1.8 раза, а пик с  $E_b=3.8\,\mathrm{eV}$  уменьшается в 3.5 раза. При  $E_{kin}\sim 70-80\,\mathrm{eV}$  вклад фотоэлектронов от поверхности и приповерхностной области преобладает в спектре, однако вклад в электронную плотность валентных состояний монослоя Na мал по сравнению с вкладом от приповерхностного слоя  $Na_xAu_y$ , валентная зона которого сформирована в основном электронами Au 5d [14]. Похожие результаты были получены при расчете ме-

тодом теории функционала плотности, например, для адсорбированного монослоя Cs на Mo(001) [15]. Спектр валентной зоны при энергии возбуждения  $h\nu=120\,\mathrm{eV}$  изменяет свою форму, пик с  $E_b=6.1\,\mathrm{eV}$  уменьшается на 15%, а пик с  $E_b=3.8\,\mathrm{eV}$  уменьшается в 1.6 раза. Такое поведение связано с тем, что при  $E_{kin}\sim110-120\,\mathrm{eV}$  вклад от поверхности становится меньше, чем от приповерхностной области, но и вклад из глубины образца мал. Таким образом, сравнение ранее полученных данных по формированию различных интерметаллидов от  $Cs_x Au_y$  до  $Li_x Au_y$  [3,16–18] при напылении атомов ЩМ на поверхность Au совместно с расчетами валент-

ной зоны NaAu [14] с экспериментальными данными, полученными в настоящей работе, позволяет сделать вывод, что после напыления на поверхность Au атомов Na на поверхности формируется монослой атомов Na, под которым происходит образование интерметаллидов  $Na_xAu_y$  различной стехиометрии.

### Благодарности

Исследовательский проект был поддержан Российско-Германской лабораторией на BESSY II. Авторы благодарят HZB за выделение времени пучка синхротронного излучения.

## Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-02-00370.

### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- [1] W.E. Spicer, Phys. Rev., 125 (4), 1297 (1962).DOI: 10.1103/PhysRev.125.1297
- [2] М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев, ЖТФ, **74** (7), 99 (2004). [M.V. Knat'ko, M.N. Lapushkin, V.I. Paleev, Tech. Phys., **49** (7), 905 (2004). DOI: 10.1134/1.1778866].
- [3] В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, ФТТ, **50** (2), 365 (2008). [V.N. Ageev, Yu.A. Kuznetsov, Phys. Solid State., **50** (2), 379 (2008). DOI: 10.1134/S1063783408020261].
- [4] D.L. Schlagel, M.F. Besser, C.D. Yuen, H. Walen, E.J. Kwolek, P.A. Thiel, T.A. Lograsso, J. Alloys Compd., 789, 362 (2019). DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.02.204
- [5] M.V. Knatko, M.N. Lapushkin, Rapid Commun. Mass Spectrom., **35** (17), e9144 (2021). DOI: 10.1002/rcm.9144
- [6] M. Jansen, Chem. Soc. Rev., 37 (9), 1826 (2008).DOI: 10.1039/b708844m
- [7] S. Tanuma, C.J. Powell, D.R. Penn, Surf. Interface Anal., 43 (3), 689 (2011). DOI: 10.1002/sia.3522
- [8] C.D. Wagner, L.E. Davis, W.M. Riggs, Surf. Interface Anal., 2 (2), 53 (1980). DOI: 10.1002/sia.740020204
- M.C. Hanf, L. Haderbache, P. Wetzel, C. Pirri, J.C. Peruchetti,
  D. Bolmont, G. Gewinner, J. Vac. Sci. Technol. A, 7 (4), 2670 (1989). DOI: 10.1116/1.575771
- [10] K. Fujiwara, A. Tsukazaki, K. Fujiwara, A. Tsukazaki, J. Appl. Phys., 125 (8), 085301 (2019). DOI: 10.1063/1.5079719
- [11] O. Bouvard, A. Krammer, A. Schüler, Surf. Interface Anal., 48 (7), 660 (2016). DOI: 10.1002/sia.5927
- J. Nerlov, S.V. Christensen, S. Weichel, E.H. Pedersen,
  P.J. Moiler, Surf. Sci., 371 (2-3), 321 (1997).
  DOI: 10.1016/S0039-6028(96)00988-0
- [13] A. Schellenberger, R. Schlaf, C. Pettenkofer, W. Jaegermann,
  Phys. Rev. B, 45 (7), 3538 (1992).
  DOI: 10.1103/PhysRevB.45.3538
- [14] R.E. Watson, M. Weinert, Phys. Rev. B, 49 (11), 7148 (1994).
  DOI: 10.1103/PhysRevB.49.7148

- [15] S.R. Chubb, E. Wimmer, A.J. Freeman, J.R. Hiskes,
  A.M. Karo, Phys. Rev. B, 36 (8), 4112 (1987).
  DOI: 10.1103/PhysRevB.36.4112
- [16] Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин, ФТТ, **63** (10), 1701 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.10.51460.127 [Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin, Phys. Solid State, **63**, 1711 (2021). DOI: 10.1134/S1063783421100218].
- [17] Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин, ФТТ, **62** (11), 1949 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50075.130 [Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin, Phys. Solid State, **62** (11), 2197 (2020). DOI: 10.1134/S1063783420110189].
- [18] V.N. Ageev, Yu.A. Kuznetsov, N.D. Potekhina, J. Phys.: Condens. Matter, 22 (8), 084005 (2010).
   DOI: 10.1088/0953-8984/22/8/084005